

МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (Power MOSFET)

INTERSIL является мировым лидером в производстве **Power MOSFET**.

Выпускаются как n-канальные, так и p-канальные транзисторы, но первые используются чаще и имеют больший диапазон токов и напряжений. Кроме этого выпускаются полевые транзисторы с управлением сигналом логического уровня, с ограничением тока, с защелкой по напряжению.

Области применения: регуляторы, конвертеры, драйверы двигателей, реле и мощных биполярных транзисторов. Полевые транзисторы имеют очень высокое входное сопротивление и обычно могут управляться непосредственно от микросхемы без дополнительных усилительных каскадов.

Power MOSFET, серия IRF

Максим. значения		TO-204		TO-220AB		TO-247		DIP-4		
V _{си} , В	I _{си} , А	R _{си(отр.)} , Ом								
п-канал										
100	1,0	0,6							IRFD110	
	1,3	0,3							IRFD120	
	5,6	0,54			IRF510					
	9,2	0,27		IRF120		IRF520				
	14,0	0,16		IRF130		IRF530				
	28,0	0,077				IRF540		IRFP140		
200	40,0	0,055	IRF150				IRFP150			
	0,6	1,5						IRFD210		
	0,80	0,8						IRFD220		
	3,3	1,5		IRF610						
	5,0	0,8		IRF220		IRF620				
	9,0	0,4		IRF230		IRF630				
400	18,0	0,18	IRF240		IRF640		IRFP240			
	33,0	0,085	IRF250				IRFP250			
	2,0	3,6		IRF710						
	3,3	1,8								
	5,5	1,0		IRF330		IRF730				
	10,0	0,55				IRF740				
500	16,0	0,3	IRF350				IRFP350			
	23,0	0,2					IRFP360			
	2,5	3,0				IRF820				
	4,5	1,5				IRF830				
	8,0	0,85	IRF440		IRF840					
	14,0	0,4	IRF450				IRFP450			
20,0	0,27					IRFP460				
р-канал										
100	1,0	0,6							IRFD9120	
	3,0	1,2		IRF9510						
	6,0	0,6		IRF9520						
	12,0	0,3		IRF9130		IRF9530				
	19,0	0,2		IRF9140		IRF9540		IRFP9140		
200	3,5	1,5			IRF9620					
	6,5	0,8			IRF9630					
	11,0	0,5	IRF9240		IRF9640					

Mega FET серия

Максим. значения		TO-220AB	
V _{си} , В	I _{си} , А	R _{си(отр.)} , Ом	
п-канал			
50	15	0,1	RFP15N05
	25	0,047	RFP25N05
	50	0,22	RFP50N05
100	22	0,080	RFP22N10
	40	0,040	RFP40N10
р-канал			
50	8	0,300	RFP8P05
	15	0,150	RFP15P05
	30	0,065	RFP30P05
п-канал, управление логическим уровнем			
50	4	0,800	RFP4N05L
	15	0,100	RFP15N05L
	25	0,047	RFP25N05L
	50	0,022	RFP50N05L
100	2	1,050	RFP2N10L
	12	0,200	RFP12N10L
200	2	3,500	RFP2N20L
	8	0,500	RFP8N20L
р-канал, управление логическим уровнем			
30	10	0,225	RFP10P03L



Более подробную информацию можно получить по адресу www.semi.intersil.com или в офисе **ПЛАТАН**, т/ф: (095) **417-5245**, **417-0811**, **417-8645**; E-mail: intersil@platan.ru

п-канальные MOSFET, серия BUZ

Максим. значения	Максимальные значения			Максимальные значения	Максимальные значения		
	V _{си} , В	I _{си} , А	R _{си(отр.)} , Ом		V _{си} , В	I _{си} , А	R _{си(отр.)} , Ом
50	14,0	0,1		200	9,5	0,4	BUZ32
	30,0	0,04		400	3,0	1,8	BUZ76
	9,0	0,25	BUZ72A		5,5	1,0	BUZ60
100	19,0	0,1	BUZ21	500	4,0	2,0	BUZ42
	200	5,8	0,6		BUZ73A		

Улучшенные Power MOSFET

Максим. значения			TO-220AB
V _{си} , В	I _{си(отр.)} , А	R _{си(отр.)} , Ом	RLP5N08LE
80	5,5	0,12	

RLP5N08LE
Имеют встроенную схему, ограничивающую max значения I_{си} на уровне 1 А и 5,5 А соответственно. Встроенный стабилитрон защищает от статического электричества до 2 кВ.

Максим. значения			TO-220AB
V _{си} , В	I _{си(отр.)} , А	R _{си(отр.)} , Ом	RLP1N06CLE
55	1	0,75	

RLP1N06CLE
Имеют схему ограничения I_{си}, защелку по напряжению (уровень 60÷70 В), встроенный стабилитрон для защиты от статического электричества до 2 кВ.